

05.4;07;09

©1995

**ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  
ПЛЕНОК  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  С РАЗНЫМ СВЧ  
ПОВЕРХНОСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ  
МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ  
ДИФРАКТОМЕТРИИ В ПЛОСКОСТЯХ,  
НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ОСИ  $c$**

*О.Г.Вендиk, Е.К.Гольман, А.Г.Зайцев,  
П.К.Петров, С.В.Разумов*

В последнее время в ряде публикаций сообщается об исследованиях, направленных на нахождение зависимости между микроструктурой пленок  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  (YBCO) и их свойствами как на постоянном токе [1,2], так и в СВЧ диапазоне [3].

Пленки YBCO, исследуемые в данной работе, были получены из мишени стехиотерического состава (диаметр 76 мм) в параллельной магнетронной системе на постоянном токе в среде чистого кислорода. Пленки с одинаково хорошими критическими параметрами на постоянном токе (критическая температура  $T_c = 89-91$  К, критическая плотность тока  $j_c = (1-3) \cdot 10^6$  А/см<sup>2</sup> при 77 К) и разным СВЧ поверхностным сопротивлением  $R_{\text{пов}}$  были получены на подложках (001)  $\text{LaAlO}_3$  размером 1 × 1 см при технологических режимах, выбранных случайно в следующих диапазонах: ток разряда 150–300 мА, давление рабочего газа 0.5–2 Тор, температура подложки  $T_{\text{подл}} = 665$  °C.

Полученные пленки YBCO имели хорошо ориентированную орторомбическую структуру с осью  $c$ , перпендикулярной к поверхности подложки. Толщина, измеренная оптическим интерферометром, составляла около 3000 Å. Параметр  $c$ , измеренный для этих пленок, был 11.67 Å, что является стандартным для высококачественных пленок YBCO.

СВЧ поверхностное сопротивление образцов измерялось при температуре 77 К на 60 ГГц в цилиндрическом медном резонаторе [4]. Нужно отметить, что данный метод измерения не позволяет измерить поверхностное сопротивление ниже, чем  $R_{\text{пов}}$  меди ( $\approx 50$  мОм при 77 К).

Рентгеновские дифрактограммы снимались дифрактометром "Geigerflex" серии  $D/\max-Rc$  Rigaku. Съемка проводилась на  $\text{Cu } K_\alpha$  ( $\lambda = 1.5418$  Å) излучение с монохроматором.

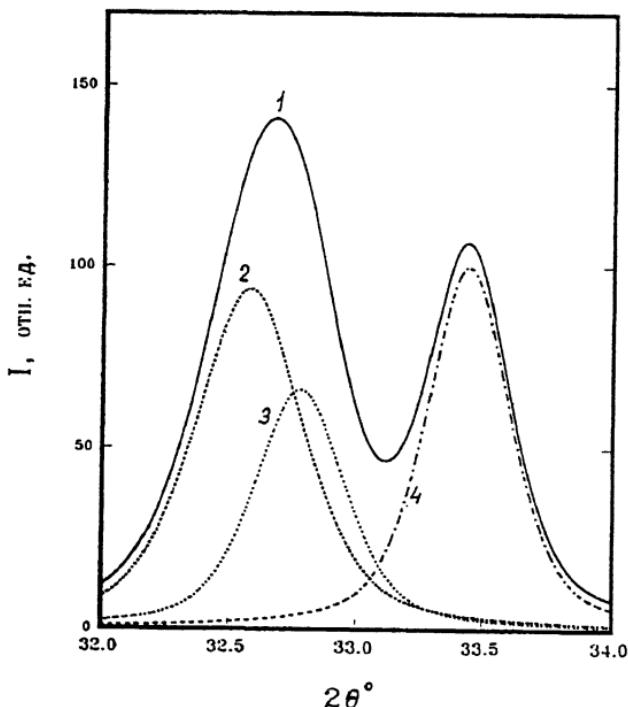


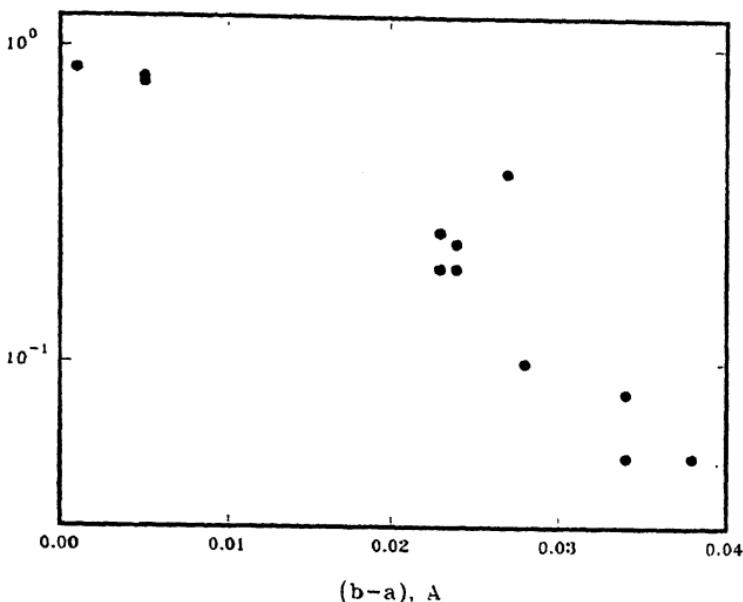
Рис. 1. Кривые качания для образца № 160 ( $R_{\text{пов}} < 0.05 \text{ Ом}$ ):

1 — экспериментальная кривая, 2 — кривая, рассчитанная для пика (013) YBCO, 3 — кривая, рассчитанная для пика (110) YBCO, 4 — кривая, рассчитанная для пика (110) LaAlO<sub>3</sub>.

Исследования микроструктуры пленок YBCO методом рентгеновской дифрактометрии в плоскости (00l) показали наличие зависимостей между параметрами рефлексов, наблюдавшихся на рентгенограмме при  $\theta - 2\theta$  — сканировании (положение максимума пиков, их форма, интегральная интенсивность и т.д.) и электрическими свойствами пленок на постоянном токе ( $T_c$ ,  $j_c$ ) [1,3]. В [2] было также отмечено, что имеется зависимость между отношением интегральных интенсивностей (00l)/(005) и насыщенностью структуры кислородом. Однако зависимость между величинами параметров рефлексов (измеренных в направлении оси c) и СВЧ поверхностным сопротивлением не найдена [3].

Поэтому в данной работе измерения проводились в плоскостях с индексами (0kl) и (hkl) (т.е. в плоскостях, неперпендикулярных оси c).

Кривую качания снимали в диапазоне (32–34) 2θ градуса. В этом диапазоне должны наблюдаться два пика для пленки YBCO ((013) и (110)) [5] и пик (110) для подложки LaAlO<sub>3</sub>. Экспериментально полученная кривая (рис. 1, сплошная линия), была подвергнута компьютерной обработке по стан-



**Рис. 2.** Зависимость между СВЧ поверхностным сопротивлением  $R_{\text{пов}}$  и степенью орторомбичности YBCO пленок.

дарному алгоритму. Данный алгоритм базируется на методике Хинделеха и Джонсона, подробно описанной в [6], где форма пиков описывается по следующей формуле:

$$F(\theta) = f A_t \exp \left[ -\ln 2 [2(\theta - \theta_t)/W_t]^2 \right] + (1-f) \frac{A_t}{1 + [2(\theta - \theta_t)/W_t]^2}, \quad (1)$$

где  $F(\theta)$  — форма пика,  $f$  — коэффициент Гаусса [1] этого пика,  $A_t$  — интенсивность пика,  $\theta_t$  — положение максимума этого пика,  $W_t$  — полная ширина пика на половине его максимума интенсивности.

В предыдущих экспериментах зависимость между коэффициентом Гаусса для пика (005) и СВЧ поверхностным сопротивлением  $R_{\text{пов}}$  исследуемых пленок не наблюдалась. Учитывая это, для уменьшения времени компьютерной обработки коэффициент Гаусса в расчетах формы кривых был принят равным 0.5. Полученные кривые были откалиброваны по интенсивности и положению максимума пика (110) LaAlO<sub>3</sub>. По полученным положениям максимумов калибранных кривых, применяя формулу Вульфа-Брэгга, находили величины межплоскостных расстояний  $d_{(013)}$  и  $d_{(110)}$ . Затем были рассчитаны величины параметров  $b$  и  $a$  кристаллической решетки пленок YBCO по формуле,

$$\frac{b^2}{d^2} = \frac{b^2}{d^2} h^2 + k^2 + \frac{b^2}{d^2} l^2, \quad (2)$$

Образец	160	154	159	163	162	161	158	152
$R_{\text{поп}}, \text{ОМ}$								
60 ГГц, 77 K	< 0.05	0.05–0.08	0.10	0.20–0.24	0.24–0.26	0.40	0.77–0.80	0.85
$d_{(013)}, \text{\AA}$	2.748	2.746	2.741	2.741	2.738	2.746	2.744	2.743
$d_{(110)}, \text{\AA}$	2.732	2.728	2.720	2.723	2.719	2.731	2.736	2.736
$c, \text{\AA}$	11.668(9)	11.676(6)	11.676(6)	11.669(9)	11.663(6)	11.672(7)	11.669(1)	11.666(2)
$b, \text{\AA}$	3.883	3.875	3.861	3.863	3.857	3.876	3.872	3.870
$a, \text{\AA}$	3.845	3.841	3.833	3.839	3.834	3.849	3.867	3.869
$\Delta = b - a, \text{\AA}$	0.038	0.034	0.028	0.024	0.023	0.027	0.005	0.001

где  $a$ ,  $b$  и  $c$  — параметры кристаллической решетки пленок YBCO,  $h$ ,  $k$  и  $l$  — индексы Миллера,  $d$  — межплоскостное расстояние.

Результаты расчетов приведены в таблице.

Как видно из таблицы, корреляция между параметрами кристаллической решетки ( $d_{(013)}$ ,  $d_{(110)}$ ,  $c$ ,  $b$  и  $a$ ) и поверхностным сопротивлением пленок YBCO не наблюдается. Однако прослеживается тенденция уменьшения  $R_{\text{пов}}$  с ростом разности величины параметров  $b$  и  $a$  кристаллической решетки, что видно на рис. 2.

Таким образом, найдена зависимость между СВЧ поверхностным сопротивлением и степенью орторомбичности YBCO пленок.

Авторы приносят благодарность М.А.Яговкиной за проведение рентгеновских исследований и помочь в интерпретации полученных результатов.

### Список литературы

- [1] Hollmann E.K., Petrov P.K., Rauser D.G., Razumov S.V., Vendik O.G., Zaitsev A.G. // Proc. of Forth International Conference on Electron Beam Technologies. Varna, World Scientific, 1994. P. 279–283.
- [2] Ye J., Nakamura K. // Phys. Rev. B. 1993. V. 48. P. 7554.
- [3] Humphrey R. // Third Symposium on High Temperature Superconductors in High Frequency Fields. Cologne, 1994.
- [4] Гайдуков М.М., Клименко В.Л., Козырев А.Б., Солдатенков О.И. // СЭФТ. 1993. Т. 6. С. 336.
- [5] Takayama-Muramachi E., Ushida Y., Matsui Y., Kato K. // Jap. J. Appl. Phys. 1987. V. 26. N 5. P. 619–620.
- [6] Hindle A.M., Johnson D.J. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1971. V. 4. P. 259.

Поступило в Редакцию  
7 декабря 1994 г.